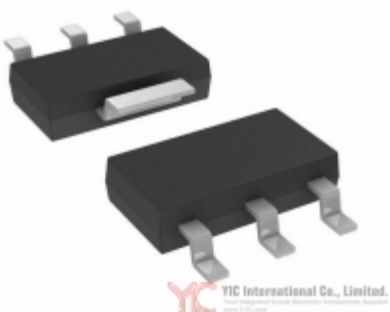








	<h2 style="color: red;">FDT55AN06LA0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDT55AN06LA0</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 12.1A SOT223-4</p> <p>Datenblätter: 1.FDT55AN06LA0.pdf 2.FDT55AN06LA0.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 24146 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT55AN06LA0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 12.1A SOT223-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24146 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 12.1A (Tc) 8.9W (Tc) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	8.9W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	46 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1130pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDT55AN06LA0DKR

FDT55AN06LA0 ist neu im Original, Suche FDT55AN06LA0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT55AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT55AN06LA0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDT459N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.5A SOT-223</p>	 <p>FDT461N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 0.54A SOT-223</p>	 <p>FDT86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223</p>	 <p>FDT461N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 0.54A SOT-223</p>
 <p>FDT86102 FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-223</p>	 <p>FDT459N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.5A SOT-223</p>	 <p>FDT86106LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p>	 <p>FDT55AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12.1A SOT223-4</p>

heiße Teile

Mehr

04023C271KAT2A	1808CC393KAT1A	AC1206KXX7R9BB474	APS1056IGV-0.6-T1	AT45DB161D-TU-2.5
AZ2215-01L.R7G	BAT46W-V-GS08	BU8768FV-E2	BZD17C5V1P-GS08	CR05AS-8-CT1
FAN9611MX	FDT1600N10ALZ	FDT1600N10ALZ	FDT3N40TF	FDT3N40TF
FDT434P-NL	FDT439N-NL	FDT458P-NL	FDT55AN06LA0	FDT86102LZ
FDT86102LZ	FDT86106LZ	FDT86106LZ	FDT86113LZ	FDT86113LZ
FDT86244	FDT86244	FDT86246	FDT86246	FDT86246L
FDT86246L	FDT86256	FDT86256	GRM0336T1E7R6CD01D	HT82V738
LTC1392CS8#TRPBF	LTC3728LEUH-1#TRPBF	MAX4536ESE+T	MCP9501PT-085E/OT	MIC5014YM
MM3404A12URE	NE3503M04-T2	P4SMA510A	PEB7274HV1.2	S-812C30AUA-C2KT2G
SN74HC126N	T388N800TOF	V30C15C150BL2	VLCF5028T-4R7N1R5-2	XC9225A13CMR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited